(19)

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 02257341 A

(43) Date of publication of application: 18,10.90

(51) lot, CI

G06F 12/06

G06K 17/00 H04N 5/907

(21) Application number: 01079587

(71) Applicant:

CANON INC

(22) Date of filing: 30.03,89 (72) Inventor:

HORII HIROYUKI MIMURA TOSHIHIKO

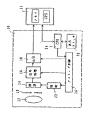
(54) INFORMATION RECORDING DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To record information without any trouble even when a memory device using many kinds of memory elements are replaced and used by detecting specification information on a loaded solid-state memory device and controlling the timing of access to the solid-state memory device according to detection information.

CONSTITUTION: A semiconductor memory device 11 is detachable from a camera main body 10 and when the power source of the camera main body 10 is turned on, a CPU 24 makes a communication with the loaded semiconductor memory device 11 to detect the specification information on the semiconductor memory device 11. The operation speeds of circuits 14, 16, 18, and 22 are determined according to the information to control a timing control circuit 26. Consequently, the solid-state memory device 11 which uses various memory elements can be utilized.

COPYRIGHT: (C)1990, JPO& Japio



⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平2-257341

®Int. CL.5

識別紀号 庁内勢理番号 〇公開 平成2年(1990)10月18日

G 06 F G 06 K H 04 N

ADR

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

公発明の名称 情報記録装置

> രവർട 類 平1--79587

ØH; 頭 平1(1989)3月30日

神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キャノン株式会社 60発 明 著 壢 井 博之

弁理士 田中 常雄

玉川惠業所内 角発 明 者 = # 神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キヤノン株式会社

玉川事業所内 の出 額 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

1. 発明の名称・

例代 理 人

情報配給装置

2. 特許請求の顧那

豊茂自在な関係メモリ装置に情報を記録する値 選であって、装着された衛体メモリ装置の仕様値 報を接知する機知手段を設け、当該機知手段の検 知情報に従い施護団はメモリ装置へのアクセス・ タイミングを制御することを特徴とする情報記録 2 T .

3:発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は賃貸記録装置に関し、より具体的には、 メモリ・カードのような関係メモリ要子を記録機 体として使用する情報記録装置に関する。

[従来の技術]

単直体メモリ素子をカード化した情報記録装置、 即ち、1 Cカードやメモリ・カード等が各種のデ 一夕の記録媒体又は廣送手段として使用されるよ うになった。そのメモリ君子には、SRAM、D

RAM, EPROM. EEPROMIZINSS.

[発明が解決しようとする課題]

上記各メモリ君子の虚き込み速度(又は時間) は、素子毎に大きく異なる。従って、メモリ容器 が増す程、書き込み時間の差は顕著になる。

書き込み途度に応じた適切な速度でデータを転 送しないと、複名込みを失致し、データを失うこ とにもつながりかねない。

そこで本発明は、このようなメモリポ子の指導 に自動対応できる情報記録等器を提示することを 目的とする。

[課題を解決するための手段]

本発明に係る情報記録装置は、着続息在な遺体 メモリ装置に賃報を記録する装置であって、装着 された翻体メモリ装置の仕様情報を検知する検知 手段を設け、当該検知手段の検知情報に従い当該 関体メモリ装置へのアクセス・タイミングを斜部 することを特徴とする。

FFE BB 1

上記手段により、記録に際して、団体メモリ装

特別平2-257341(2)

震のメモリ素子に即したアクセス・タイミングで 当該関体メモリ装置への転送を行なう。これによ り、関本のメモリ素子を使用する関体メモリ装置 を利用できるようになる。

以下、図面を参照して本発明の実施例を説明す ス。

第1 図は、半等体/モリ袋型を存止器を砂程体として使用するスタル・カメラ (以下、関セカメラという。)に本意物を透用した場合の一果洗料の構成プロ・ク図を表す。1 0 セカメラ本体、1 1 は、上記を類の半等体/モリ素子及びその対象の対象を見るである。大力との・年本はメモリ製造11 はカノラ本体10 から超数自在である。カメラ本体において、12 は関節レンズ、13 ボイン・ナック、14 はC C D などの団体操像素子、16 は G 等級国際 5 1 は ス/フ度映画、2 2 は 建像条子14 の駆動回路、18 は ス/フ度映画、2 2 は 定条件 14 の駆動回路、2 4 は全体を制御する C P U、2 6 は回筒 2 2 1 に 1 8 1 8 1 8 2 0 の動

作タイミングを規定するタイミング制御回路、2 8は各種スイッチ及び表示装置を異様する表示・ スイッチ装置である。

第2回のフローチャートを表現して知1回の砂 作を設明する。カメラ本は10の電配がインされ と(S1)、半端はメモリ接直11の装填を持 つ(S2)。そして、CPU24は、装填された 半導体メモリ装直11との間で遺信を行ない、半 場子の接張、転送スピードの上間、残容置など) を検知する(S3)。CPU24はこの情報に づいて回路14、16、18、22の動作スピー ドを決定し、タイミング制卸回路28を制即する。 ここで、撮影をが、表示、スイッチ装置28の シャッタ・スイッチを買すと、レッッタ13が ま、上記のタイミングにより温度素子14の出力 が信号処理回路16およびA/D 変数器13を介 して半導体メモリ装置11に転送され、書き込ま れる。

S3で得られたメモリ情報に基づいて、最大連

写スピードが挟まるので、表示・スイッチ優量 2 8の表示装置により、設定し得る最大適等スピー ドを表示する (S 4)。以後、半導体メモリ装置 11の取り外しを監視する (S 5)。

第3個は本発明の別の実施例の構成プロック図 である。第1数と間じ場成要素には限じ符号を付 してある。本実施例では、A/D変換器18によ りディジタル化された強強データをフレーム・よ モリ30に一時保存するようにしていある。フレ ーム・メモリ30に一時保存された調像データは、 半導体メモリ11のメモリ妻子の転送スピードに 適合するスピードでプレーム。メモリ30から捷 み出され、半導体メモリ装置11に響き込まれる。 上記事権制では、重進体メモリコミの基準性に カメラ本体10のCPU24が半導体メモリ装置 11に使用メモリ票子の程類などを開い合せる機 成を採用したが、半導体メモリ装置11に上記各. 獲情報を機械的に設定しておき、カメラ本体10 側には、この機械的設定情報を検切する倫切系母 を設けるようにしてもよい。こうすれば、CPU

間の遺信の手間が省ける。

本実施的では、半導体メモリ製産の書き込み可 能なスピードに、量大選写スピードを制限し、こ れを表示するので、簡体カメラの使い勝手、特に 連写撮影の操作性が向上する。

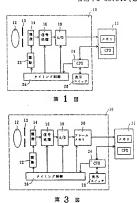
以上の説明では、固体カメラを例に取ったが、 本発明は、御脱目在な固体メモリ装置に返る疑の 情報を起始しようとする装置一般に適用可能であ る。関体カメラでは、

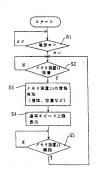
[発明の効果]

以上の設明から容易に理解できるように、本発 明によれば、多種多様のメモリ業子のメモリ装置 を交換使用しても、支険無く情報を記録できるよ うになる。

4. 懇談の職単な説明

第1間は本発明の一実施門の構成プロック型、 第2間はそのフローチャート、第3回は本発明の 変更実施例の構成プロック型である。

10:カメラ本体 13:半導体メモリ装置 1 2:提影レンズ 13:シャッタ 14:排砂煮 



第 2 图